## 06;09

## Спектральные свойства и антистоксовая люминесценция керамики и стекла TeO<sub>2</sub>-BaF<sub>2</sub>:Ho<sup>3+</sup>, Ho<sup>3+</sup>/Yb<sup>3+</sup> при возбуждении излучением 1.9 µm Tm:LiYF<sub>4</sub>-лазера

© А.П. Савикин, А.С. Егоров, А.В. Будруев<sup>¶</sup>, И.Ю. Перунин, О.В. Крашенинникова, И.А. Гришин

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород <sup>¶</sup> E-mail: budruev@gmail.com

Поступило в Редакцию 14 марта 2017 г.

Показано преобразование ИК-излучения лазера Tm: LiYF<sub>4</sub> с длиной волны 1908 nm в видимый свет с максимумом 650 nm керамикой состава (100 - x)TeO<sub>2</sub>-xBaF<sub>2</sub>-1 wt% HoF<sub>3</sub>-yYbF<sub>3</sub>, где x = 20, 30, 40 mol.%, y = 0 или 0.5 wt%. На образцах 60TeO<sub>2</sub>-40BaF<sub>2</sub>-1 wt% HoF<sub>3</sub>-0.5 wt% YbF<sub>3</sub> наблюдалась антистоксовая люминесценция при пороговой плотности мощности излучения 1.0-1.5 W · cm<sup>-2</sup>.

## DOI: 10.21883/PJTF.2017.14.44829.16771

Выбор материала для преобразования ИК-излучения с длиной волны 1.9  $\mu$ m в видимый свет обусловлен наличием явления кооперирования ионов гольмия во фторидной керамике с малой величиной энергии высокочастотных фононов [1–4]. Этим параметрам соответствует фторид бария, энергия высокочастотных фононов которого имеет величину порядка  $hv_{phon} \approx 225 \,\mathrm{cm^{-1}}$  [5]. Ионы гольмия в структуре флюорита и пространственной группе Fm3m занимают позиции тетрагональной и тригональной симметрии, что благоприятствует апконверсии. Мы положили, что при охлаждении расплава TeO<sub>2</sub>-BaF<sub>2</sub> с высокой концентрацией фторида бария и добавкой фторида гольмия будет образовываться поликристаллическая фаза флюоритового типа BaF<sub>1-x</sub>Ho<sub>x</sub>F<sub>2+x</sub>. Разработка методики получения такого материала и исследование его люминесцентных свойств являлись целью данной работы.

34



Рис. 1. Рентгенограммы керамики (I) состава 80TeO<sub>2</sub>-20BaF<sub>2</sub>-1 wt% HoF<sub>3</sub>, стекла (2) состава 80TeO<sub>2</sub>-20BaF<sub>2</sub>-4 wt% Ho<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и эталонного образца BaF<sub>2</sub> (3).

В синтезе использовали фториды бария, гольмия, иттербия и оксид теллура квалификации ОСЧ. Состав шихты соответствовал общей формуле (100 - x)TeO<sub>2</sub> – xBaF<sub>2</sub> + 1 wt% HoF<sub>3</sub> + yYbF<sub>3</sub>, где y = 0 или 0.5 wt%, а x = 20, 30, 40 mol.%. Компоненты перетирались и выдерживались в керамической кювете при 700–750°C 10–15 min до расплавления. Медленное охлаждение расплава приводило к образованию кристаллической керамики, а быстрое — к образованию непрозрачной стеклокерамики.

Для получения стекла при охлаждении расплава  $\text{TeO}_2-\text{BaF}_2:\text{Ho}^{3+}$ гольмий вводился в шихту в виде оксида, так как оксиды редкоземельных элементов повышают устойчивость теллуритных стекол к кристаллизации [6].

Фазовую индивидуальность полученных образцов контролировали методом рентгенографии. Съемка рентгенограмм при комнатной температуре проводилась на рентгеновском дифрактометре XRD-6000 фирмы Shimadzu (Cu $K_1$ -излучение, геометрия съемки на отражение) с шагом сканирования  $0.02^{\circ}$  в интервале удвоенного угла  $10-60^{\circ}$ . Рентгеновский анализ (рис. 1) выявил различие в структуре кристаллической керамики и полученного стекла. Первая (рис. 1, кривая *1*)

представляла собой твердый раствор со структурой флюорита, с полным совпадением отражений с эталонным образцом BaF<sub>2</sub> (рис. 1, кривая *3*). Структура второго образца была аморфной (рис. 1, кривая *2*).

Спектры пропускания стекла в видимом и ближнем ИК-диапазонах, полученные на спектрофотометрах СФ-56, Shimadzu UV-3600 и Varian 660-IR, использовались для построения диаграммы энергетических уровней ионов  $Ho^{3+}$  в  $BaF_2$ . Спектры отражения керамики составов  $60TeO_2-40BaF_2-1$  wt%  $HoF_3$ ,  $80TeO_2-20BaF_2-1$  wt%  $HoF_3$ ,  $80TeO_2-20BaF_2-1$  wt%  $HoF_3$ ,  $80TeO_2-20BaF_2-1$  wt%  $HoF_3-0.5$  wt% YbF\_3 в видимом диапазоне спектра измерялись на спектрофотометре СФ-14.

Полосы поглощения переходов из основного состояния  ${}^{5}I_{8}$  ионов гольмия на возбужденные уровни  ${}^{5}I_{7}$ ,  ${}^{5}I_{6}$ ,  ${}^{5}I_{5}$ ,  ${}^{5}F_{4}$ ,  ${}^{5}F_{5}$ ,  ${}^{5}S_{2}$ ,  ${}^{5}F_{4}$  в стеклах, вследствие сильного неоднородного уширения, были гладкие, с двумя максимумами интенсивности. Спектры отражения керамик имели сложную структуру полос, зависящую от состава керамики и температуры синтеза. Форма полос обусловлена перераспределением интенсивностей переходов между энергетическими состояниями штарковских подуровней. При этом длины волн, середин полос во всех образцах имели постоянное значение, что позволило, с учетом точности измерений спектров поглощения  $\delta\lambda \pm 1$  nm, построить диаграмму энергетических уровней ионов гольмия в исследуемых образцах (рис. 2).

Коротковолновая полоса поглощения перехода  ${}^{5}I_{7} \rightarrow {}^{5}I_{7}$  ионов гольмия в образцах  $80\text{TeO}_{2}-20\text{BaF}_{2}$  имела ширину по уровню 0.5 от максимального значения, равную  $\Delta \tilde{\nu}_{0.5} \approx 145 \text{ cm}^{-1} \ (\pm 10 \text{ cm}^{-1})$ . Общая ширина полосы, определяющая спектральный диапазон ИК-излучения, возможного для преобразования в видимый диапазон иК-излучения, возможного для преобразования в видимый диапазон спектра, равнялась  $\Delta \tilde{\nu}_{0.5} \approx 300 \text{ cm}^{-1} \ (\pm 10 \text{ cm}^{-1})$ . Спектр поглощения по уровню 0.1 заключен в спектральном диапазоне 1855-2095 nm. Наибольшая величина сечения поглощения, соответствующая длине волны  $1950 \text{ nm} - \sigma (\lambda = 1950 \text{ nm}) \approx 0.2 \cdot 10^{-20} \text{ cm}^{2}$ . На длине волны излучения Tm: LiYF<sub>4</sub> (Tm: YLF) лазера  $\sigma (\lambda = 1908 \text{ nm}) \approx 0.1 \cdot 10^{-20} \text{ cm}^{2}$ .

В спектре антистоксовой люминесценции, как и в спектрах отражения, наблюдалась только красная полоса при 650 nm, соответствующая переходу  ${}^{5}F_{5} \rightarrow {}^{5}I_{8}$  с расщеплением полосы на величину порядка  $\Delta \tilde{\nu} \approx 400 \text{ cm}^{-1}$  (рис. 3).



**Рис. 2.** Диаграмма энергетических уровней  $Ho^{3+}$  в стекле  $80TeO_2 - 20BaF_2 - 4$  wt%  $Ho_2O_3$ .

В эксперименте определялась минимальная (пороговая) плотность мощности излучения лазера Tm:YLF, при которой на образце визуально наблюдалось пятно антистоксовой люминесценции. Для основ 60TeO<sub>2</sub>-40BaF<sub>2</sub> антистоксовая люминесценция наблюдалась при интенсивности возбуждающего излучения начиная с  $I_{\rm min} \approx (0.50-0.65) \, {\rm W} \cdot {\rm cm}^{-2}$ . Для основ 80TeO<sub>2</sub>-20BaF<sub>2</sub> величина пороговой интенсивности возрастала до  $I_{\rm min} \approx 1.5 \, {\rm W} \cdot {\rm cm}^{-2}$ . При дополнительном легировании ионами Yb<sup>3+</sup> (0.5 wt%) интенсивность люминесценции красной полосы увеличивалась, а величина пороговой плотности мощности снижалась до  $I_{\rm min} \approx 1.0 \, {\rm W} \cdot {\rm cm}^{-2}$ .

Как было показано [2–4], заселение уровня  ${}^{5}F_{5}$  осуществляется главным образом за счет кооперирования энергии ионов Ho<sup>3+</sup>, находящихся в состояниях  ${}^{5}I_{7}$ ,  ${}^{5}I_{6}$  и  ${}^{5}I_{5}$ . Возможны по крайней мере два пути заселения уровня  ${}^{5}F_{5}$ . Первый — при взаимодействии двух ионов, находящихся в состояниях  ${}^{5}I_{6}$ , переходы: ( ${}^{5}I_{6} \rightarrow {}^{5}I_{8}$ ) ( ${}^{5}I_{6} \rightarrow {}^{5}F_{5}$ ). При



Рис. 3. Спектр антистоксовой люминесценции ионов  $\text{Ho}^{3+}$ . Образцы: 80 $\text{TeO}_2$ -20 $\text{BaF}_2$  - 1 wt%  $\text{HoF}_3$  - 0.5 wt% YbF<sub>3</sub> (1) и 80 $\text{TeO}_2$ -20 $\text{BaF}_2$  - 1 wt%  $\text{HoF}_3$  (2).

этом избыток энергии возбуждения, переходящий в колебания кристаллической решетки, составляет величину  $\Delta E \approx 1800 \, \mathrm{cm^{-1}}$ . Второй — при взаимодействии двух ионов, находящихся в состояниях  ${}^{5}\mathrm{I}_{7}$  и  ${}^{5}\mathrm{I}_{5}$ , например ( ${}^{5}\mathrm{I}_{7} \rightarrow {}^{5}\mathrm{I}_{8}$ ) ( ${}^{5}\mathrm{I}_{5} \rightarrow {}^{5}\mathrm{F}_{5}$ ).

Отсутствие в спектрах антистоксовой люминесценции зеленой полосы в области 545 nm можно объяснить малой величиной населенности уровня <sup>5</sup>I<sub>4</sub> вследствие большой вероятности внутри центровой релаксации порядка  $W_{NR} \approx 10^5 \, {\rm s}^{-1}$  (величина энергетического зазора  $\Delta E = E({}^5{\rm I}_4) - E({}^5{\rm I}_5) \approx 2150 \, {\rm cm}^{-1}$ ), присущей матрицам, содержащим TeO<sub>2</sub> [7–9]. Энергия высокочастотного фонона в образцах 60TeO<sub>2</sub>-40BaF<sub>2</sub> имела величину  $hv_{ph. \, max} \approx 685 \, {\rm cm}^{-1}$ . С другой стороны, большая энергия фонона обеспечивала большую величину вероятности  $W^{tr}(\Delta E)$  межионного переноса энергии вследствие дипольдипольного взаимодействия двух ионов Ho<sup>3+</sup>, находящихся в состояния x <sup>5</sup>I<sub>6</sub> с разбалансом  $\Delta E$ , перекрываемым за счет испускания фононов.

Проведенные сравнительные оценки показали, что вероятность заселения уровня  $^5F_5$  по первому пути для матрицы  $80 TeO_2 - 20 BaF_2$ 

на несколько порядков превышает вероятность заселения для матрицы BiF<sub>3</sub> ( $h\nu_{ph. \max} \approx 257 \,\mathrm{cm}^{-1}$ ). Оценки  $W^{tr}(\Delta E)$  проводились согласно методике, изложенной в работах [2,10].

Увеличение интенсивности люминесценции в образцах с дополнительным легированием  $Yb^{3+}$  можно объяснить увеличением населенности состояния  ${}^{5}I_{6}$  ионов  $Ho^{3+}$ . Сначала происходит перенос энергии от ионов  $Ho^{3+}$ , находящихся в состоянии  $5I_{5}$  к ионам  $Yb^{3+}$ . Затем ионы  $Yb^{3+}$ , находящиеся в состоянии  ${}^{2}F_{5/2}$ , возвращают энергию ионам  $Ho^{3+}$ , соответствующие переходы в ионах  $Yb^{3+}$ :  $({}^{2}F_{5/2} \rightarrow {}^{2}F_{7/2})$  и в ионах  $Ho^{3+}$ :  $({}^{5}I_{8} \rightarrow {}^{5}I_{6})$ .

Таким образом, использование основы TeO<sub>2</sub>–BaF<sub>2</sub> позволило получить керамику, преобразующую излучение лазера Tm:YLF в люминесценцию только в области 650 nm. Дополнительное легирование керамики Yb<sup>3+</sup> (0.5 wt%) приводило к уменьшению пороговой плотности мощности с  $I_{min} \approx 1.5$  до  $\approx 1.0 \, \mathrm{W} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$ . Показано, что антистоксовая люминесценция наблюдается только в кристаллической фазе BaF<sub>2</sub>. Предлагаемый материал не имеет аналогов и может быть использован как визуализатор двухмикронного излучения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части государственного задания ННГУ, проект № 4.5706.2017/БЧ.

## Список литературы

- Lyapin A.A., Ryabochkina P.A., Ushakov S.N., Fedorov P.P. // Quant. Electron. 2014. V. 44 (6). P. 602.
- [2] Savikin A.P., Egorov A.S., Budruev A.V. et al. // Tech. Phys. Lett. 2016.
  V. 42 (11). Р. 1083. [Савикин А.П., Егоров А.С., Будруев А.В. и др. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. В. 21. С. 47.]
- [3] Savikin A.P., Egorov A.S., Budruev A.V., Grishin I.A. // Opt. Spectr. 2016.
  V. 120 (6). Р. 902. [Савикин А.П., Егоров А.С., Будруев А.В., Гришин И.А. // Оптика и спектроскопия. 2016. Т. 120. В. 6. С. 963.]
- [4] Savikin A.P., Egorov A.S., Budruev A.V., Grishin I.A. // Inorg. Mater. 2016.
  V. 3 (52). Р. 309. [Савикин А.П., Егоров А.С., Будруев А.В., Гришин И.А. // Неорганические материалы. 2016. Т. 52 (3). С. 352.]
- [5] Gan F. // J. Non-Cryst. Solids. 1995. V. 184. P. 9.
- [6] Wang J.S., Vogel E.M., Snitzer E. // Opt. Mater. 1994. V. 3 (3). P. 187.

- [7] Layne C.B., Lowdermilk W.H., Weber M.J. // Phys. Rev. B. 1977. V. 16 (1).
  P. 10.
- [8] Yeh D.C., Sibley W.A. // J. Appl. Phys. 1987. V. 62 (1). P. 266.
- [9] Wetenkamp L, West G.F., Tobben H. // J. Non-Cryst. Solids. 1992. V. 140. P. 35.
- [10] Auzel F. // Phys. Rev. B. 1976. V. 13. P. 2809.